Elektronikll-Yaz-2012-Yılici-4	Adı.
CIEKTIOHIKII- I az-zu i z- I IIICI-4	AUI.

Soyadı:

No:

Dikkat: Cevaplarınızı soru altlarındaki boşluklara yapınız.

Imza:

\$1 Şekil-3'te verilen devredeki tranzistorlardan T1 T2 ile,

TB1 ise TB2 ile eşdir. Ayrıca bütün tranzistorlar için |V_{BE}|≅0.6V, β_F =100, V_A=100V ve V_T≅25mV değerleri verilmektedir.

 $Vi=V_{B1}=0V$ iken $Vo=V_{C3}=0V$, $V_{C2}=V_{B3}=6V$ ve $I_{C1}=I_{C2}=I_{C3}=1$ mA olsun istenmektedir. Devredeki dirençlerin değerlerini bulunuz.

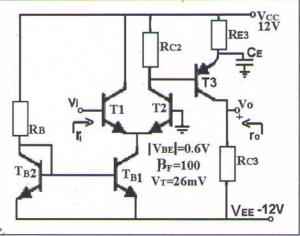
(15Puan)

Ver= Vec-Icz-Rez=6V Ma=11,7K/

RCZ = 12-6 = 6KM

VES = VO3 + 0,6V = 6,6V= VCL-IE3 RES

7 nes=5,4k// Vo=Vc1=0 = I concs + VEE => ncs = -VEE = 12k/



S2 Şekildeki devrede MOS tranzistorlar için $\beta_p = \beta_n = 100 \mu \text{A/V}^2$, $V_{\text{Th-n}} = 1 \text{V}$, V_{Th-p}=-1V, V_{An} = V_{Ap} = 50V değerleri verilmektedir. Vi=2.5V'luk DC çalışma

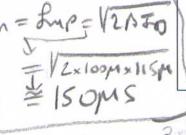
noktasında tranzistorların ID akımı ~115uA olduğuna göre vo/vi ac kazancı ne olur bulunuz. (20Puan)

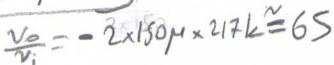
Vo = Pmn. Vi. Po + Pmp. Vi. Po = (Pmn+Rmp) Colivi

Vo = - (Run + Rup). To Jun = Lup = 12150

To= Corll Con= Cosplicasn = 15 Opus Gir= Pasn = Fo = 435k

6 = 217k





VDD

ro

S3 Şekildeki devrede vo/(vi1-vi2) ne olur bulunuz.(20Puan)

Darlington yapı isin; fi = 5miz

Parlington + HVBAG(Me) Ich, PM = Pm 1+Prile

